科学研究**費**助成事業

亚成 30 年 5日 10日

研究成果報告書

	平成	30	年	5	月	10	日現在
機関番号: 82723							
研究種目: 基盤研究(C)(一般)							
研究期間: 2014~2017							
課題番号: 26420069							
研究課題名(和文)揺動機構内蔵スピンドルを有する硬脆ウエハ研削盤の開発	発						
研究課題名(英文)Development of hard and brittle wafer-grinding machine equipped with vibration assisted spindle system							
研究代表者							
由井 明紀(Yui, Akinori)							
防衛大学校(総合教育学群、人文社会科学群、応用科学群、電気情報学群) 授	及びシ.	ステノ	ΔŢ·	シス	テム	、工学	群・教

研究者番号:70532000

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,900,000円

研究成果の概要(和文):LEDや半導体パワーディバイスなどの広範な実用化に伴い,高品位・低価格な基板用 サファイアウエハの高能率生産が求められている.一方,サファイアウエハは高硬度な脆性材料であり,難削材 として位置付けられている.そこで,磁気アクチュエータを用いて砥石スピンドルをアキシャル方向に振動させ るシステムを開発しロータリ研削盤に搭載した.試作機を用いて,サファイアの振動援用インフィード平面研削 加工を試みた.その結果,難削材料であるサファイアウエハに対しては加工時間の短縮と研削比の向上が実現で きた.

研究成果の概要(英文): Consumption of sapphire wafer has been expanding for LED board and/or power device. Due to the excellent mechanical properties, sapphire wafer is hard to grinding. On the other hand, ultrasonic assisted grinding applies to machining of difficult to grind materials and shows the effect of high-efficiency machining. However, because the cup grinding wheel is heavy, it cannot be applied to ultrasonic grinding. The authors, developed a grinding wheel vibration system and applied infeed surface grinding of sapphire and silicon wafer. Although, high efficiency grinding could be realized for sapphire wafer, it cannot realized for silicon wafer.

研究分野:工学

キーワード:研削 振動 サファイア ウエハ 加工時間 研削比 表面性状 ロータリ研削盤

1.研究開始当初の背景

サファイアは,その優れた機械的特性,熱的 特性,化学的安定性,光学特性などからエレクト ロニクス産業を支える基板材料として重要性を 増している.特に窒化ガリウムなどの半導体材料 と容易に格子整合するため,薄膜成長用基板と して各方面から市場の発展性が期待されている. 特に,高輝度化が期待できるLEDや,高電圧で 大電流を扱うことができ高周波動作が可能な半 導体パワーディバイス用基板などとして広範な 需要が見込まれる.近年では,ウエ八の基板サ イズは2インチから4インチへ大径化し,今後は 6 インチウエ八の量産技術の確立が急がれてい る.

一方, 硬脆材料であるサファイアウエハは, そ の優れた機械的特性に起因して難加工材料で あり, 特に研削工程における加工能率の向上は 産業界の大きな課題とされている. 硬脆材料の 加工能率を向上させる手法の一つとして, 振動 援用加工が報告されている. 工具あるいは工作 物に周波数 10kHz および振幅数 µm~数 10µm の超音波振動を付与することで, 高能率な加工 が実現できている.

すなわち,加工面に対し超音波振動を付与 することで,工作物の微細な破壊・排除が促進さ れ材料除去が容易になることや,加工領域への 研削液の侵入により研削抵抗が低下するなどの 利点が報告されている.これを硬脆ウエハ研削 盤に応用すれば,研削抵抗が低下することで消 費電力が抑制でき,ウエハ製造工程における加 工コストの削減が期待できる.

しかし,ウエハの平面研削においてはカップ 砥石を必要とするため,可動体の質量が大きく なることに起因して超音波を重畳することが困難 であり,振動援用研削に関する研究成果も報告 されていない.

研究の目的

本研究では,新たに振動援用砥石スピンドル システムを開発し,その運動性能を評価すると 伴に,カップ形ダイヤモンド砥石を搭載してシリ コンウエハおよびサファイアウエハのインフィード 平面研削加工を行い,振動援用効果について 実験的に考察する.

研究の方法

3.1. 振動援用スピンドルシステムの設計

供試砥石スピンドルは, 図1 に示すようにソレ ノイドタイプの磁気アクチェータによる切込み機 構を内蔵しており, 砥石回転中にアキシャル方 向にインフィード研削ができる構造になっている. 図2 および表1 に示すように,高い磁束密度を 有する磁気アクチュエータのコイルが,励振磁 束(実線)を導く.その結果,電機子の上下表面 に生じる磁束密度を変化させアキシャル方向の 駆動力 F が生じる.

図 3 にウエハのインフィード研削加工の状況 を示す.ロータリ研削盤のテーブル上面に設置 した,真空チャックにより吸着したウエハの高さ は,プローブ式定寸装置を用いてチャック基準



表1 磁気アクチュエータの仕様

ネオジム磁石の磁束密度	[T]	1.3
磁石(内径×外径×厚さ)	[mm]	129×205×20
コイル巻き数	[巻]	78
コイル数	[個]	32
コイル(内径×外径×厚さ)	[mm]	125×203×2
ステータ内側磁極面積	$[mm^2]$	7464
ステータ外側磁極面積	$[mm^2]$	12240
最大軸受すきま	[mm]	1.5
電機子(外径×厚さ)	[mm]	126×25



図3 ウエハのインフィード研削加工

面とインプロセス比較測定する.ウエハ高さが定 寸値に達した時点でインフィード送りを停止させ る.その後,一定時間スパークアウト研削を行い, 砥石はリトラクトするシステムとなっている.

3.2 振動機構搭載スピンドルの性能

本研究では,砥石スピンドルにアキシャル方 向振動機能を持たせるためのソフトウェア開発を 行った.カップ砥石は,一定速度でインフィード 切込みを行いながら,アキシャル方向に振動さ せる.

図 4 に振動援用研削における砥石先端位置 の軌道イメージを示す.砥石軸をアキシャル方 向に一定速度で移動させながら,周期 1μs の三 角波パルス列を発振させて移動指令を重畳させ ることで砥石軸の振動制御を行う.指令両振幅 *a*μm,指令周波数*f*Hz で砥石軸を振動させた時 の三角波振動速度 *a*·*f*μm/s とインフィード送り速 度 *F*μm/s から実際の切込み速度 *F*_rμm/s は(1) 式で与えられる.

$$F_r = 2(af + F) \tag{1}$$

すなわち,振動研削における最大切込み速度 F_r は設定した砥石送り速度Fより大きくなる.

3.3 振動援用スピンドルの性能評価

表 2 に試作した砥石スピンドル振動システム の仕様を示す.図5に示すように,試作したスピ ンドル先端位置の振動周波数と振幅を変化させ て,追従性能を評価する.(a)に示す指令値が高 くなると伴に振動周波数の実測値は減衰し,(b) に示す実測値は16Hz以上で追従しなくなる.ま た,振動周波数15Hzにおける最大振幅は1µm p-p 程度に減衰する.

指令周波数に追従しない理由は、本システム の指令クロック(1µs)に達するまでは反転信号が 出力されないことに起因する.また、最大送り速 度に制限があるため、指令振幅が 20µm p-p 以 上になると追従できずに減衰してしまう.

3.4 研削加工条件

ウエハの研削加工条件を表 2 に,カップ砥 石の振動条件を表 3 に示す.粗粒ダイヤモン ド砥石による一般的な粗研削の加工条件を選 定し,外径150mm高さ100µmを除去する際の 振動援用研削と加工性能を比較する.

ドレッシング後に同一条件で2回研削加工 を行い,2枚目のウエハを研削した際の測定 値を実験結果として示す.ダイヤモンド砥石の 損耗量は,ウエハ1枚研削毎にブロックゲージ (1.5mm)と砥石軸の上下送り機構を用いて, 砥石加工面と工作物の隙間を測定することに より比較測定を行う.なお,砥石軸上下 送り軸の表示分解能は0.1nmである.

また,加工中の研削抵抗は直接計測 することができないため,クランプ電流計 (HIOKI電機製,クランプオンパワーハイ テスタ3169-01)を砥石スピンドルに内蔵するビ ルトインモータの電源部に設置し,消費電力を 測定して接線研削抵抗に数値換算する.さら に,研削後のウエハ表面性状は,非接触式表 面性状測定装置(Zygo, New View6K)を用い



図4 ウエハ揺動研削時の砥石軌道イメージ



図 5 砥石振動周波数と振幅の追従性能の評価

表 2 研削加工条件

ウェハ	種類	サファイアウエハ		
917	外径	150[mm]		
砥石	形状	6 号ストレート形		
	砥粒	ダイヤモンド#325		
	括 米百	SD325MX655GP25		
	个生犬只	旭ダイヤモンド製		
インフィ-	- ド速度	0.83[µm/s]		
除去量		100[µm]		
スパーク	アウト時間	5[s]		
ドレッシング用砥石		GC280		
トレッンノク用城 石		6C280		

表3 カップ砥石の振動条件

条件	А	В	С	D
指令両振幅 [µm]	0	20.26	4.95	1.83
指令周波数 [Hz]	0	0.97	8.69	15.24
切込み速度 [µm/s]	0.83	40.13	86.86	56.61

て,外周部 5mm 部の算術平均粗さ Ra を比較 測定する.

3.5 砥石振動振幅の影響

サファイアウエハのインフィード平面研削に おける振動振幅の影響を図 6~図9に示す. いずれも指令周波数は1Hzの条件における測 定結果である.図中の中空記号で示す値は砥 石に振動を付与した場合で,左軸上の中実記 号で示す値は砥石に振動を付与しない場合を 示す.

図 6 右軸に砥石振動振幅と砥石切込み速 度の関係を示す.砥石振動振幅の上昇に比 例して砥石切込み速度は高くなる.左軸に砥 石振動振幅と砥石摩耗高さの関係を示す.振 動を付与しない条件(振幅 0µm p-p)では,ウ エハ上に脱落した遊離砥粒によるラッピング作 用により砥石の摩滅摩耗が促進し,砥石摩耗 高さが大きくなるものと考えられる.

振幅 5~10µm p-p の領域では研削油剤の 侵入が容易になり,切り屑の排出が促進され, 砥石摩耗高さは1µm以下まで小さくなる.これ は,砥石の摩滅摩耗と自生発刃のバランスが 良くとれている状態だと考えられる.振動振幅 10µm p-p以上では,砥石とウエ八の衝突速度 の上昇に伴い,砥石の自生発刃が活発になり 砥粒が脱落することにより砥石摩耗高さが大き くなるものと考えられる.

図 7 に, 砥石振動振幅が正味研削時間に 及ぼす影響について示す.振動を付与しない (振幅 0µm p-p)場合と比較して,振動を付与 することで正味研削時間は短縮される.これは, 研削油剤の侵入性と切り屑排出性,そして砥 石の自生発刃に伴い,切れ味が良くなったこと に起因すると考えられる.

さらに,振動振幅が大きくなると伴に正味研 削時間は徐々に長くなる.これは,振幅が大き くなると砥石と工作物が離れて仕事をしない時 間が長くなることにより,正味加工時間が長く なるものと考えられる.本実験の範囲では,砥 石の振動振幅 1μm p-p の条件で正味加工時 間は最も短くなる.

図8に砥石振動振幅とウエハの算術平均粗 さの関係を示す. 揺動を付与しない(振幅 0μm p-p)時の粗さが 0.22μmRa と最も小さくなる.こ れは,砥石が摩滅摩耗して砥粒先端とウエハ の間に滑りが発生して粗さが小さくなるものと 考えられる.砥石振動振幅の上昇に伴い,砥 石の自生発刃が支配的になるため,ウエハ表 面の算術平均粗さは大きくなるものと考えられ る.

29 に, 砥石振動振幅と砥石スピンドル消

費電力の関係を示す.前述のように,振動を 付与しない場合には,砥石の摩滅摩耗が支配 的になるため切れ味が悪く,消費電力は大きく



なる. 振動を付与することにより消費電力は低 下し, 振動振幅 1~10μm p-p の領域では振動 による消費エネルギーの上昇に伴い, 消費電 力が徐々に上昇する.

振動振幅が 10µm p-p 付近を超えると, 消費 電力は振幅の上昇と伴に低下する.これは, 砥石と工作物が離れている時間が長くなり, 切 り屑を排出しない時間が長くなる分だけ消費 電力量は低くなるものと考えられる.ただし, 振 幅が大きい領域では, 正味加工時間が長くな るため, 電力量としては大きくなる.

3.6 砥石振動周波数の影響

サファイアウエハのインフィード平面研削に おける砥石振動周波数の影響を図 10~図 13 に示す.いずれも,指令振幅 1µm p-p の条件 における測定結果である.砥粒切込み速度は 式(2)より算出した結果であり,周波数上昇に 伴う振動振幅減衰の影響も考慮されている.

図 10 右軸に砥石振動周波数と砥石切込み 速度の関係を示す.振動周波数の上昇に伴い,砥石切込み速度は上昇するが,振動周波 数が 5Hz 付近を超えると,切込み速度は約 9µm/s でほぼ一定になる.これは,砥石振動周 波数の上昇に伴い振動振幅が減衰することに より,砥石切込み速度の上昇が制限されること に起因する.

左軸に砥石摩耗高さと砥石振動周波数の 関係を示す.振動を付与しない(周波数 0Hz) の場合に砥石摩耗高さが大きくなるのは,前 述の通り遊離砥粒によるラッピング作用による 砥石の摩滅摩耗によるものと考えられる.振動 周波数が 8.7Hz 付近に至るまでは,振動周波 数の上昇に伴い砥石摩耗高さも大きくなる.こ れは,切込み速度の上昇により,砥石の自生 発刃が徐々に活発になるためだと考えられる.

振動周波数が 8.7Hz 付近を超えると, 砥石 摩耗高さは徐々に小さくなる.これは, 砥石切 込み速度が一定になるため, 砥石の自生発刃 も一定になる.一方振動の重畳により遊離砥 粒や切り屑の排出も活発になり, 砥石の摩滅 摩耗が抑制され, 砥石摩耗高さは徐々に低下 したものと考えられる.

図 11 に, 砥石振動周波数が正味研削時間 に及ぼす影響について示す.振動を付与しない(周波数 0Hz)場合に正味研削時間が 205s と長くなるのは,前述の通り, 砥石の摩滅摩耗 が進み, 切れ味が悪いためだと考えられる.

砥石振動周波数 8.7Hz 付近で正味研削時 間は 180s で最小値となり,振動を付与しない 場合より約 12%短縮される.砥石振動周波数 が 8.7Hz 付近を超えると,徐々に正味研削時 間は長くなる.これは前述のように,砥石摩耗 高さが小さくなることにより,砥石の切れ味が 徐々に低下し,正味研削時間が長くなるものと 思われる.

図 12 に, 砥石振動周波数がウエハの算術 平均粗さに及ぼす影響を示す.振動を付与し ない(周波数 0Hz 時の算術平均粗さが最も小 さく,振動周波数の上昇に伴い粗さは大きくな り,8.7Hz 付近で最大値を示す.前述のように, 砥石に振動を付与しない場合は,砥粒の摩滅 摩耗による滑りが発生してウエハの表面粗さは 小さくなるが,振動周波数の上昇に伴い,砥 粒の自生発刃が促進され,ウエハの算術平均 粗さが大きくなるものと考えられる.

振動周波数が 8.7Hz 付近を超えると表面粗



(指令振幅 1µm p-p)

さは小さくなるが,これは砥石摩耗高さが抑制 されたことに起因するものと考えられる.

図13に, 砥石振動周波数と砥石スピンドル 消費電力の関係を示す.振動周波数の上昇 に伴い消費電力は低下する.これは,振動周 波数の上昇に伴い砥石が自生発刃することに より新しい切れ刃が現れ,切削抵抗が低くな ることに起因すると考えられる.砥石振動周波 数 8.7Hz 付近で砥石摩耗高さが最も大きくな るため砥石の切れ味が良くなり,消費電力は 最も低くなる.さらに,砥石振動周波数が高く なると,消費電力は上昇に転じる.これは,砥 石摩耗高さが小さくなり,砥石の切れ味が劣 化することに起因するものと考えられる.



及ぼす影響(指令振幅 1μm p-p)

4. 研究成果

インフィード研削中のカップ砥石に,アキシャ ル方向の振動を重畳できる砥石スピンドルシステ ムを開発した.本システムを搭載したロータリ研 削盤を用い,サファイアウエハの平面ロータリ研 削を行い,本実験条件下で以下の結論を得た.

- 1) 砥石振動周波数 1Hz の条件では,振動振幅 1µm p-p において最もスピンドル消費電力が 低くなり,正味研削時間も短縮される.
- 4) 砥石振動振幅 1µm p-p の条件では,振動周 波数 8.6Hz において最も消費電力が低くなり, 正味研削時間も短縮される.
- 3) 砥石摩耗高さは,振動振幅5~10µm p-pある いは,振動周波数1Hzの条件で最も小さくなる.
- 4) サファイアウエハ表面の算術平均粗さは,振動を付与しない方が小さい.
- 5.主な発表論文等
- 〔学会発表〕(計2件)
- 1) 藪野 真大, サファイアウエハのロータリ研削 における砥石揺動効果に関する研究, 砥粒 加工学会, 砥粒加工学会学術講演会, 2017.
- 2) 藪野 真大,切込機構内蔵砥石スピンドルを 用いたシリコンウエハの揺動研削に関する研

究, 砥粒加工学会, 砥粒加工学会学術講演会, 2016.

6.研究組織

(1)研究代表者
由井 明紀(YUI AKINORI)
防衛大学校・システム工学群・教授
研究者番号:70532000

(2)研究分担者

北嶋 孝之(KITAJIMA TAKAYUKI)
防衛大学校・システム工学群・准教授
研究者番号: 5046174

- (3)研究協力者 A.H.Slocum マサチューセッツ工科大学・教授
 - X-D.Lu

ブリティッシュコロンビア大学・准教授

楠山 純平(KUSUYAMA JUNPEI) 防衛大学校・後期博士課程学生